



Communiqué de presse

KIOXIA va toujours plus loin en matière de performance avec ses nouveaux dispositifs à mémoire flash embarqués UFS ver 3.1

Conçus avec la cinquième génération de mémoire flash BiCS FLASH™ 3D, ces derniers offrent des profils plus fins et des vitesses de lecture/d'écriture plus rapides pour les applications exigeantes.

KIOXIA

**Thinner Profile,
Faster Read/Write Speeds**

256GB and 512GB UFS v3.1 Sampling Now

KIOXIA
UFS

BiCS FLASH™

Düsseldorf, Allemagne, 11 août 2021 – [KIOXIA Europe GmbH](#) a annoncé aujourd'hui l'échantillonnage de sa toute dernière génération de dispositifs de mémoire flash embarqués de 256 et de 512 gigaoctets (Go) conformes à la norme UFS (Universal Flash Storage) version 3.1. Contenus dans des boîtiers de 0,8 mm et 1,0 m de haut, les nouveaux produits permettent

d'améliorer de 30 % la lecture aléatoire et de 40 % l'écriture aléatoire^[1] – les rendant plus fins^[2] et plus rapides que leurs prédécesseurs. Les nouveaux dispositifs KIOXIA UFS utilisent la mémoire flash BiCS FLASH™ 3D la plus récente, de cinquième génération et haute performance conçue par l'entreprise et sont destinés à une variété d'applications mobiles.

Le large éventail d'applications prenant en compte les défis de consommation et de place et qui utilisent la mémoire flash embarquée nécessite encore et toujours des performances et une densité plus élevées, ce qui fait de l'UFS une solution de plus en plus choisie. En nombre total de gigaoctets, l'UFS représente désormais la majorité de la demande par rapport à l'e-MMC. Selon Forward Insights, si l'on combine la demande globale en gigaoctets d'UFS et d'e-MMC dans le monde, près de 70 % de la demande cette année concerne l'UFS, et cette tendance n'est pas prête de diminuer^[3].

« Avec la nouvelle version 3.1 de l'UFS, notre leadership constant dans le domaine de la standardisation JEDEC nous permet de faire une nouvelle percée en matière de performances et de facteurs de forme pour les mémoires non volatiles embarquées », indique Axel Stoermann, vice-président marketing et ingénierie des mémoires chez KIOXIA Europe GmbH. « Des contrôles réguliers ainsi que le développement continu de la technologie de mémoire flash 3D BiCS FLASH™ de KIOXIA permettent non seulement de proposer une nouvelle gamme de produits offrant une vitesse de lecture et d'écriture aléatoires dans les formats de conditionnement les plus fins, mais offrent également aux nouveaux appareils le potentiel de devenir la solution privilégiée pour un large éventail d'applications industrielles exigeantes. »

Les nouveaux appareils UFS 256 Go et 512 Go présentent les avancées suivantes :

- Une amélioration des performances de 30 % en lecture aléatoire et de 40 % en écriture aléatoire.
- Host Performance Booster (HPB) Ver. 2.0 : améliore les performances de lecture aléatoire en utilisant la mémoire côté hôte pour stocker les tables de conversion d'adresses logiques en adresses physiques. Alors que HPB Ver. 1.0 permet uniquement un accès à des parties d'une capacité de 4 Ko, HPB Ver. 2.0 permet un accès plus large, ce qui peut améliorer les performances de lecture aléatoire.
- Un boîtier 256 Go plus fin et d'une hauteur d'à peine 0,8 mm

Remarques :

[1] En comparaison avec la génération précédente des UFS 256/512 Go KIOXIA.

[2] Dans le cas d'une densité de 256 Go, comparée à la génération précédente des UFS 256 Go de KIOXIA.

[3] Source : Forward Insights 2ème trim. 21

Universal Flash Storage (UFS) désigne une catégorie de produits correspondant à une classe de mémoires embarquées et conformes à la norme JEDEC UFS.

La vitesse de lecture et d'écriture peut varier selon le dispositif hôte, les conditions de lecture et d'écriture, ainsi que la taille du fichier.

Pour chaque mention d'un produit KIOXIA : La densité du produit est identifiée sur la base de la densité de la (ou des) puce(s) au sein même du produit et non pas sur la capacité totale de mémoire disponible pour le stockage de données par l'utilisateur final. La capacité utilisable par l'utilisateur est moindre, du fait de zones de données supplémentaires, du formatage, d'éventuels blocs défectueux, et d'autres contraintes, et elle peut également varier selon le dispositif hôte et l'application. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux spécifications de produits applicables. La définition de 1 Ko = 2^{10} octets = 1 024 octets. La définition de 1 Gbit = 2^{30} bits = 1 073 741 824 bits. La définition de 1 Go = 2^{30} octets = 1 073 741 824 octets. 1 To = 2^{40} octets = 1 099 511 627 776 octets.

Les noms de société, de produits et de services mentionnés ici pourraient être des marques de leurs détenteurs respectifs.

À propos de KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (auparavant Toshiba Memory Europe GmbH) est la filiale européenne de KIOXIA Corporation, leader mondial en matière de production de mémoires flash et de disques SSD. De l'invention de la mémoire flash à la technologie révolutionnaire d'aujourd'hui avec la technologie BiCS FLASH™, KIOXIA reste pionnière dans le domaine des solutions de mémoire de pointe et des services enrichissant la vie des personnes et élargissant l'horizon de la société. L'innovante technologie de mémoire flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASH™, façonne l'avenir du stockage dans des applications à haute densité, incluant les smartphones, les PC, les SSD, les centres de données ainsi que l'automobile.

Visitez notre [site web KIOXIA](#)

Coordonnées pour des publications :

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0)211 368 77-0 E-mail :

KIE-support@kioxia.com

Coordonnées pour des requêtes éditoriales :

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tél : +49 (0) 211 36877 382

E-mail : lena1.hoffmann@kioxia.com

Émis par :

Birgit Schöniger, Publitek

Tél : +44 (0) 1582 390980

E-mail : birgit.schoeniger@publitek.com

Site web : www.publitek.com